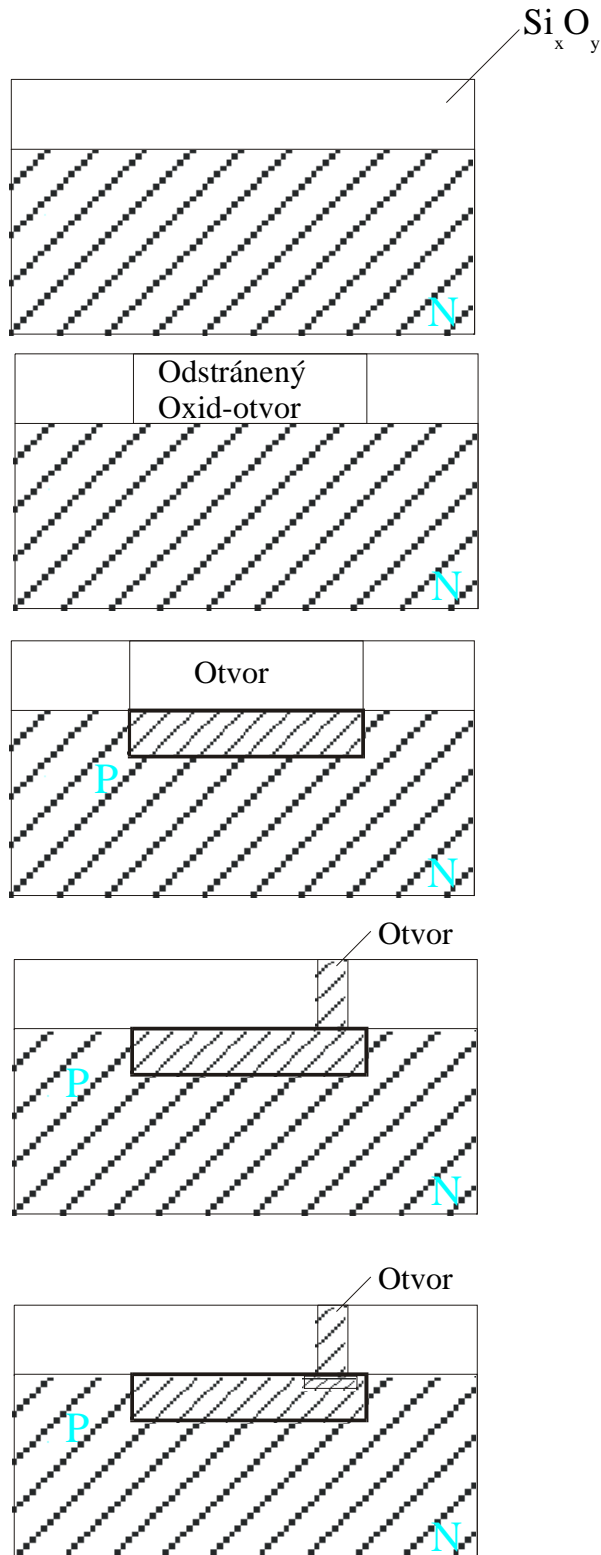


6.1 Planárna technológia

Je jedným zo základných technologických postupov výroby polovodičových súčiastok.

Technologický postup:



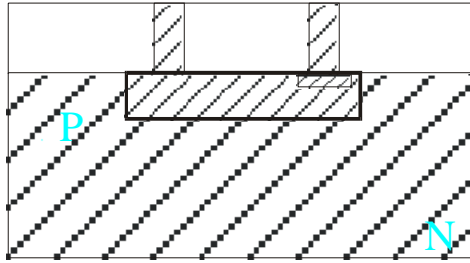
Základná doštička typu N. Z jednej strany je pokrytá ochrannou vrstvou z kysličníku Si_xO_4 . Nie je možné vytvoriť vrstvu iba jednej strany.

Je naznačené odstránenie ochrannej vrstvy. Ochranná vrstva sa odstraňuje odleptaním (HF – kyselina fluorovodíková).

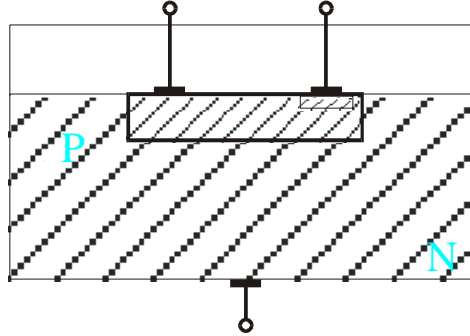
Technológiou difúzie vytvoríme priechod PN. Z obrázku vyplýva, že difúzant typu P vnikne do základného materiálu len v mieste otvoru

Na obrázku je naznačené vytvorenie otvoru pre emitor.

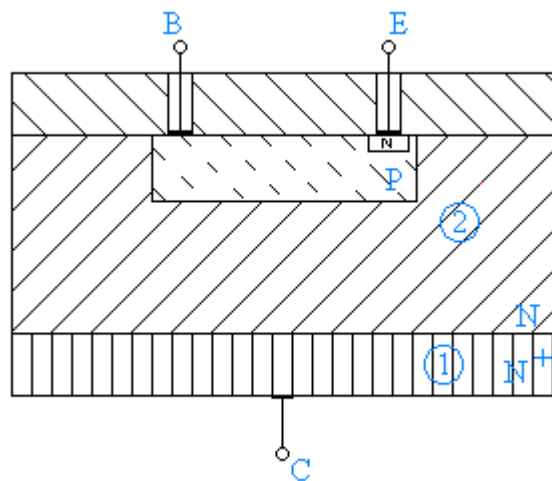
Vytvorí sa difúziou oblasť typu N – emitor



Vytvorí sa nová štruktúra ochrannej vrstvy s dvomi otvormi.



Prípojenie prívodov. Nasleduje zapuzdrenie.



základná doštička
epitaxná vrstva

